

## ■ ショットキーバリアダイオード Schottky-Barrier Diodes(SBD)

シングル 1 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>F(AV)</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max.mA	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
ERA82-004		40	0.6(Ta=45°C)	25	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =0.6A)	1		Lead-1	0.18
SC802-04	SMD	40	1.0(TI=136°C)*4	40	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =1.0A)	2		SC	0.06
SC802-06	SMD	60	1.0(TI=136°C)*4	30	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =1.0A)	2		SC	0.06
SC802-09	SMD	90	1.0(TI=131°C)*4	30	-40 to +150	0.85(I <sub>F</sub> =1.0A)	1		SC	0.06
ERA83-004		40	1.0(TI=136°C)	50	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =1.0A)	2		Lead-1	0.18
ERA83-006		60	1.0(TI=136°C)	30	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =1.0A)	2		Lead-1	0.18
ERA81-004		40	1.0(Ta=25°C)	50	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =1.0A)	2		Lead-2	0.22
ERA84-009		90	1.0(TI=131°C)*5	30	-40 to +150	0.90(I <sub>F</sub> =1.0A)	1		Lead-2	0.22
ERA85-009		90	1.0(TI=131°C)	30	-40 to +150	0.82(I <sub>F</sub> =1.0A)	1		Lead-1	0.18
SD882-02	SMD	20	2.0(TI=96°C)	70	-55 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =2.0A)	2		SD	0.035
SD832-03	SMD	30	2.0(TI=124°C)	70	-55 to +150	0.46(I <sub>F</sub> =2.0A)	1		SD	0.035
SD832-04	SMD	40	2.0(TI=120°C)	70	-55 to +150	0.51(I <sub>F</sub> =2.0A)	1		SD	0.035
SD862-04	SMD	40	2.0(TI=125°C)	80	-55 to +150	0.59(I <sub>F</sub> =2.0A)	0.1		SD	0.035
SD863-04	SMD	40	3.0(TI=116°C)	110	-55 to +150	0.59(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.1		SD	0.035
SD863-06	SMD	60	3.0(TI=115°C)	60	-55 to +150	0.62(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.1		SD	0.035
SD863-10	SMD	100	3.0(TI=105°C)	60	-55 to +150	0.84(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.1		SD	0.035
CB803-03		30	2.0(TI=133°C)	80	-40 to +150	0.47(I <sub>F</sub> =1.5A)	5		Lead-3	0.3
CB863-12		120	2.0(TI=124°C)	70	-40 to +150	0.88(I <sub>F</sub> =2.0A)	0.08 10		Lead-3	0.3
CB863-15		150	2.0(TI=116°C)	60	-40 to +150	0.90(I <sub>F</sub> =2.0A)	0.08 10		Lead-3	0.3
CB863-20		200	2.0(TI=121°C)	40	-40 to +150	1.25(I <sub>F</sub> =2.0A)	0.1 10		Lead-3	0.3
ERB83-004		40	2.0(TI=130°C)	100	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =2.0A)	5		Lead-3	0.3
ERB83-006		60	2.0(TI=130°C)	60	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =2.0A)	5		Lead-3	0.3
ERB81-004		40	2.0(TI=130°C)	100	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =2.0A)	5		Lead-4	0.5
ERB84-009		90	2.0(Ta=50°C)*6	60	-40 to +150	0.90(I <sub>F</sub> =2.0A)	2		Lead-4	0.5
SD883-02	SMD	20	3.0(TI=103°C)	70	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =3.0A)	2		SD	0.035
SD883-04	SMD	40	3.0(TI=100°C)	70	-40 to +125	0.45(I <sub>F</sub> =3.0A)	1		SD	0.035
FD807-03		30	3.0(TI=134°C)	120	-40 to +150	0.47(I <sub>F</sub> =3.0A)	5		Lead-7	1.2
FD867-12		120	3.0(TI=115°C)	100	-40 to +150	0.88(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.12 10		Lead-7	1.2
FD867-15		150	3.0(TI=113°C)	90	-40 to +150	0.90(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.12 10		Lead-7	1.2
FD867-20		200	3.0(TI=122°C)	80	-40 to +150	1.25(I <sub>F</sub> =3.0A)	0.15 10		Lead-7	1.2
SD833-03	SMD	30	3.0(TI=127°C)	70	-40 to +150	0.46(I <sub>F</sub> =3.0A)	1		SD	0.035
SD833-04	SMD	40	3.0(TI=122°C)	70	-40 to +150	0.51(I <sub>F</sub> =3.0A)	1		SD	0.035
SD833-06	SMD	60	3.0(TI=121°C)	60	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =2.5A)	1		SD	0.035
SD833-09	SMD	90	3.0(TI=112°C)	60	-40 to +150	0.85(I <sub>F</sub> =3.0A)	1		SD	0.035
SD834-03	SMD	30	4.0(TI=100°C)	70	-55 to +150	0.46(I <sub>F</sub> =4.0A)	1		SD	0.035
SD834-04	SMD	40	4.0(TI=96°C)	70	-55 to +150	0.51(I <sub>F</sub> =4.0A)	1		SD	0.035
ERC81-004		40	3.0(TI=130°C)	120	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =3.0A)	5		Lead-7	1.2
ERC81-006		60	3.0(TI=131°C)	80	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =3.0A)	5		Lead-7	1.2
ERC84-009		90	3.0(TI=122°C)	80	-40 to +150	0.80(I <sub>F</sub> =3.0A)	5		Lead-7	1.2
FD868-12		120	4.0(TI=106°C)	120	-40 to +150	0.88(I <sub>F</sub> =4.0A)	0.15 10		Lead-7	1.2
FD868-15		150	4.0(TI=102°C)	110	-40 to +150	0.90(I <sub>F</sub> =4.0A)	0.15 10		Lead-7	1.2
FD868-20		200	4.0(TI=111°C)	100	-40 to +150	1.25(I <sub>F</sub> =4.0A)	0.2 10		Lead-7	1.2
ERC81S-004		40	5.0(TI=108°C)	140	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =5.0A)	5		Lead-7	1.2

( ) 条件

\*1 抵抗負荷 \*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

\*4 ガラスエポキシ基板に装着, ランド寸法15x15mm

\*5 プリント板取り付け(ランド10x10mm)

\*6 20x20mm銅フィンを両側につける場合

( ) Conditions

\*1 Resistive load \*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

\*4 Mounted to fabric base epoxy resin printed circuits (land 15x15mm)

\*5 P.C board mounting (land 10x10mm)

\*6 Mounted Cu fins (20x20mm) on the both lead

### 記号 Letter symbols

V<sub>RRM</sub> ピーク繰返し逆電圧  
V<sub>FSM</sub> ピーク非繰返し逆電圧  
I<sub>O</sub> 平均出力電流  
I<sub>FSM</sub> サージ電流  
T<sub>j</sub> 接合温度  
T<sub>a</sub> 周囲温度  
T<sub>c</sub> ケース温度

Repetitive peak reverse voltage  
Non-repetitive peak reverse voltage  
Average output current  
Surge current  
Junction temperature  
Ambient temperature  
Case temperature

T<sub>stg</sub> 保存温度  
V<sub>FM</sub> 順電圧  
I<sub>RRM</sub> 逆電流  
t<sub>rr</sub> 逆回復時間  
R<sub>th(j-c)</sub> 熱抵抗 (接合ケース間)  
T<sub>l</sub> リード温度  
I<sub>F(AV)</sub> 平均順電流  
Storage temperature  
Forward voltage  
Reverse current  
Reverse recovery time  
Thermal resistance (Junction to case)  
Lead temperature  
Average forward current



# 整流ダイオード/Rectifier Diodes

## ■ ショットキーバリアダイオード Schottky-Barrier Diodes (SBD)

シングル 1 in one-package (Continued)

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>F(AV)</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max.mA	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
KS826S04	SMD	40	5.0(Tc=110°C)	80	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =5.0A)	5	10	K-pack(S)	0.6
YG811S04R		40	5.0(Tc=122°C)	120	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =5.0A)	5	5.0	TO-220F	2.0
YG811S06R		60	5.0(Tc=127°C)	80	-40 to +150	0.59(I <sub>F</sub> =5.0A)	5	5.0	TO-220F	2.0
YG811S09R		90	5.0(Tc=116°C)	80	-40 to +150	0.9 (I <sub>F</sub> =4.0A)	5	5.0	TO-220F	2.0
YG812S04R		45	10 (Tc=124°C)	250	-40 to +150	0.6 (I <sub>F</sub> =10A)	2	2.5	TO-220F	2.0

( ) 条件

\*1 抵抗負荷 \*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

( ) Conditions

\*1 Resistive load \*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

デュアル 2 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max.mA	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
KS823C03	SMD	30	5.0(Tc=117°C)	60	-40 to +150	0.47(I <sub>F</sub> =2.5A)	5.0	10	K-pack(S)	0.6
KS823C04	SMD	40	5.0(Tc=107°C)	60	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =2.5A)	5.0	10	K-pack(S)	0.6
KS823C09	SMD	90	5.0(Tc=100°C)	60	-40 to +150	0.9 (I <sub>F</sub> =2.5A)	5.0	10	K-pack(S)	0.6
KP823C03		30	5.0(Tc=117°C)	60	-40 to +150	0.47(I <sub>F</sub> =2.5A)	5.0	10	K-pack(P)	0.6
KP823C04		40	5.0(Tc=107°C)	60	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =2.5A)	5.0	10	K-pack(P)	0.6
KP823C09		90	5.0(Tc=100°C)	60	-40 to +150	0.9 (I <sub>F</sub> =2.0A)	5.0	10	K-pack(P)	0.6
YG801C04R		40	5.0(Tc=125°C)	100	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =2.0A)	5.0	5.0	TO-220F	2.0
YG801C06R		60	5.0(Tc=125°C)	60	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =2.0A)	5.0	5.0	TO-220F	2.0
YG801C09R		90	5.0(Tc=117°C)	60	-40 to +150	0.9 (I <sub>F</sub> =2.0A)	2.0	5.0	TO-220F	2.0
YG801C10R		100	5.0(Tc=117°C)	60	-40 to +150	0.8 (I <sub>F</sub> =1.5A)	0.7	5.0	TO-220F	2.0
YG831C03R		30	6.0(Tc=127°C)	90	-40 to +150	0.45(I <sub>F</sub> =2.0A)	5.0	5.0	TO-220F	2.0
YG831C04R		40	6.0(Tc=122°C)	80	-40 to +150	0.53(I <sub>F</sub> =2.0A)	2.0	5.0	TO-220F	2.0
KS883C02	SMD	20	7.0(Tc=89°C)	60	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =2.5A)	10.0	10.0	K-pack(S)	0.6
KP883C02		20	7.0(Tc=89°C)	60	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =2.5A)	10.0	10.0	K-pack(P)	0.6
YG881C02R		20	8.0(Tc=103°C)	80	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =2.0A)	10.0	5.0	TO-220F	2.0
YG802C03R		30	10 (Tc=126°C)	120	-40 to +150	0.47(I <sub>F</sub> =4.0A)	5.0	3.5	TO-220F	2.0
YG802C04R		40	10 (Tc=110°C)	120	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =4.0A)	5.0	3.5	TO-220F	2.0
YG802C06R		60	10 (Tc=118°C)	80	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =4.0A)	5.0	3.5	TO-220F	2.0
YG802C09R		90	10 (Tc=102°C)	80	-40 to +150	0.9 (I <sub>F</sub> =4.0A)	5.0	3.5	TO-220F	2.0
YG802C10R		100	10 (Tc=102°C)	80	-40 to +150	0.8 (I <sub>F</sub> =3.0A)	1.2	3.5	TO-220F	2.0
YG832C03R		30	12 (Tc=118°C)	120	-40 to +150	0.45(I <sub>F</sub> =4.0A)	5.0	3.5	TO-220F	2.0
YG832C04R		40	12 (Tc=112°C)	120	-40 to +150	0.53(I <sub>F</sub> =4.0A)	3.0	3.5	TO-220F	2.0
YG803C04R		40	15 (Tc=92°C)	120	-40 to +150	0.55(I <sub>F</sub> =7.0A)	3.0	3.5	TO-220F	2.0
YG803C06R		60	15 (Tc=94°C)	100	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =6.0A)	5.0	3.0	TO-220F	2.0
YG882C02R		20	16 (Tc=94°C)	120	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =4.0A)	10	3.5	TO-220F	2.0
YG805C04R		40	20 (Tc=100°C)	120	-40 to +150	0.6 (I <sub>F</sub> =10A)	15	2.5	TO-220F	2.0
YG805C06R		60	20 (Tc=108°C)	80	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =8.0A)	15	2.5	TO-220F	2.0
YG805C10R		100	20 (Tc=91°C)	100	-40 to +150	0.8 (I <sub>F</sub> =5.0A)	2.5	2.5	TO-220F	2.0
YG835C04R		40	22 (Tc=96°C)	120	-40 to +150	0.53(I <sub>F</sub> =8.0A)	6.0	2.5	TO-220F	2.0
YG835C03R		30	25 (Tc=99°C)	120	-40 to +150	0.45(I <sub>F</sub> =6.0A)	15	2.5	TO-220F	2.0
YG885C02R		20	30 (Tc=81°C)	120	-40 to +125	0.39(I <sub>F</sub> =8.0A)	30	2.5	TO-220F	2.0
YG838C04R		40	30 (Tc=85°C)	180	-40 to +150	0.53(I <sub>F</sub> =12.5A)	8	2.0	TO-220F	2.0
YG838C03R		30	38 (Tc=85°C)	200	-40 to +150	0.45(I <sub>F</sub> =12.5A)	10	2.0	TO-220F	2.0
MS808C06	SMD	60	30 (Tc=118°C)	150	-40 to +150	0.58(I <sub>F</sub> =12.5A)	3	1.2	TFP	0.8
YG808C10R		100	30 (Tc=80°C)	180	-40 to +150	0.8 (I <sub>F</sub> =10A)	20	2.0	TO-220F	2.0

( ) 条件

\*1 50Hz方形波 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2 (Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

■ 高耐圧ショットキーバリアダイオード High Voltage Schottky-Barrier Diodes

シングル 1 in one-package

型 式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質 量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max. μA	R <sub>th</sub> (j-c) °C/W		
YG861S12R		120	5 (Tc=104°C)	75	-40 to +150	0.88	150	5.0	TO-220F	2.0
YG861S15R		150	5 (Tc=94°C)	75	-40 to +150	0.9	150	5.0	TO-220F	2.0

( ) 条件

\*1 抵抗負荷 \*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

( ) Conditions

\*1 Resistive load \*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

デュアル 2 in one-package

型 式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質 量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max. μA	R <sub>th</sub> (j-c) °C/W		
YA862C12R		120	10 (Tc=137°C)	75	-40 to +150	0.88	150	1.20	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG862C12R		120	10 (Tc=122°C)	75	-40 to +150	0.88	150	3.00	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS862C12R	SMD	120	10 (Tc=137°C)	75	-40 to +150	0.88	150	1.50	T-pack(S)	1.6
TP862C12R		120	10 (Tc=137°C)	75	-40 to +150	0.88	150	1.50	T-pack(P)	1.6
YA865C12R		120	20 (Tc=126°C)	150	-40 to +150	0.88	150	1.25	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG865C12R		120	20 (Tc=116°C)	150	-40 to +150	0.88	150	1.75	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS865C12R	SMD	120	20 (Tc=126°C)	150	-40 to +150	0.88	150	1.25	T-pack(S)	1.6
TP865C12R		120	20 (Tc=126°C)	150	-40 to +150	0.88	150	1.25	T-pack(P)	1.6
PH865C12		120	20 (Tc=126°C)	150	-40 to +150	0.88	150	1.50	TO-247	4.9
YA868C12R		120	30 (Tc=122°C)	190	-40 to +150	0.88	200	1.00	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG868C12R		120	30 (Tc=116°C)	190	-40 to +150	0.88	200	1.20	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS868C12R	SMD	120	30 (Tc=122°C)	190	-40 to +150	0.88	200	1.00	T-pack(S)	1.6
PH868C12		120	30 (Tc=122°C)	190	-40 to +150	0.88	200	1.20	TO-247	4.9
YA862C15R		150	10 (Tc=134°C)	75	-40 to +150	0.90	150	1.50	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG862C15R		150	10 (Tc=117°C)	75	-40 to +150	0.90	150	3.00	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS862C15R	SMD	150	10 (Tc=134°C)	75	-40 to +150	0.90	150	1.50	T-pack(S)	1.6
TP862C15R		150	10 (Tc=134°C)	75	-40 to +150	0.90	150	1.50	T-pack(P)	1.6
YA865C15R		150	20 (Tc=115°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.25	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG865C15R		150	20 (Tc=101°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.75	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS865C15R	SMD	150	20 (Tc=115°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.25	T-pack(S)	1.6
TP865C15R		150	20 (Tc=115°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.25	T-pack(P)	1.6
▲ MS865C15	SMD	150	20 (Tc=117°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.20	TFP	0.8
PH865C15		150	20 (Tc=109°C)	150	-40 to +150	0.90	150	1.50	TO-247	4.9
YA868C15R		150	30 (Tc=119°C)	190	-40 to +150	0.90	200	1.00	TO-220AB-K1	2.0
									TO-220AB	2.0
YG868C15R		150	30 (Tc=113°C)	190	-40 to +150	0.90	200	1.20	TO-220F-K1	2.0
									TO-220F	2.0
TS868C15R	SMD	150	30 (Tc=119°C)	190	-40 to +150	0.90	200	1.00	T-pack(S)	1.6
▲ MS868C15	SMD	150	30 (Tc=113°C)	190	-40 to +150	0.90	200	1.20	TFP	0.8
PH868C15		150	30 (Tc=129°C)	190	-40 to +150	0.90	200	1.20	TO-247	4.9

( ) 条件

\*1 50Hz方形波 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

▲ 開発中

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2 (Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

▲ Under development



# 整流ダイオード/Rectifier Diodes

## ■ 高耐圧ショットキーバリアダイオード High Voltage Schottky-Barrier Diodes

デュアル 2 in one-package (Continued)

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max. μA	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
▲ YA862C20R		200	10 (Tc=111°C)	110	-40 to +150	1.25	150	1.75	TO-220AB	2.0
▲ YG862C20R		200	10 (Tc=84°C)	110	-40 to +150	1.25	150	3.00	TO-220F	2.0
▲ YA865C20R		200	20 (Tc=105°C)	130	-40 to +150	1.25	200	1.25	TO-220AB	2.0
▲ YG865C20R		200	20 (Tc=87°C)	130	-40 to +150	1.25	200	1.75	TO-220F	2.0
▲ MS865C20	SMD	200	20 (Tc=106°C)	130	-40 to +150	1.25	200	1.20	TFP	0.8
▲ MS868C20	SMD	200	30 (Tc=85°C)	150	-40 to +150	1.22	200	1.20	TFP	0.8
▲ YA872C25R		250	10 (Tc=112°C)	120	-40 to +150	2.5	200	1.50	TO-220AB	2.0
▲ YG872C25R		250	10 (Tc=85°C)	120	-40 to +150	2.5	200	3.00	TO-220F	2.0
▲ YA875C25R		250	20 (Tc=106°C)	150	-40 to +150	2.5	200	1.25	TO-220AB	2.0
▲ YG875C25R		250	20 (Tc=88°C)	150	-40 to +150	2.5	200	1.75	TO-220F	2.0

( ) 条件

\*1 50Hz方形波 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

▲ 開発中

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2 (Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

▲ Under development

## ■ 低IRショットキーバリアダイオード Low IR Schottky-Barrier Diodes

デュアル 2 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max. mA	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
YA862C04R		45	10(Tc=138°C)	125	-40 to +150	0.61	0.15	2.0	TO220AB	2.0
YG862C04R		45	10(Tc=129°C)	125	-40 to +150	0.61	0.15	3.5	TO220F	2.0
TS862C04R	SMD	45	10(Tc=138°C)	125	-40 to +150	0.61	0.15	2.0	T-pack(S)	1.6
YA865C04R		45	20(Tc=126°C)	145	-40 to +150	0.63	0.175	1.75	TO220AB	2.0
YG865C04R		45	20(Tc=115°C)	145	-40 to +150	0.63	0.175	2.5	TO220F	2.0
TS865C04R	SMD	45	20(Tc=126°C)	145	-40 to +150	0.63	0.175	1.75	T-pack(S)	1.6
YA868C04R		45	30(Tc=122°C)	160	-40 to +150	0.63	0.20	1.25	TO220AB	2.0
YG868C04R		45	30(Tc=105°C)	160	-40 to +150	0.63	0.20	2.0	TO220F	2.0
TS868C04R	SMD	45	30(Tc=122°C)	160	-40 to +150	0.63	0.20	1.25	T-pack(S)	1.6
YA862C06R		60	10(Tc=136°C)	125	-40 to +150	0.68	0.15	2.0	TO220AB	2.0
YG862C06R		60	10(Tc=124°C)	125	-40 to +150	0.68	0.15	3.5	TO220F	2.0
TS862C06R	SMD	60	10(Tc=136°C)	125	-40 to +150	0.68	0.15	2.0	T-pack(S)	1.6
YA865C06R		60	20(Tc=122°C)	145	-40 to +150	0.74	0.175	1.75	TO220AB	2.0
YG865C06R		60	20(Tc=109°C)	145	-40 to +150	0.74	0.175	2.5	TO220F	2.0
TS865C06R	SMD	60	20(Tc=122°C)	145	-40 to +150	0.74	0.175	1.75	T-pack(S)	1.6
YA868C06R		60	30(Tc=119°C)	160	-40 to +150	0.74	0.20	1.25	TO220AB	2.0
YG868C06R		60	30(Tc=101°C)	160	-40 to +150	0.74	0.20	2.0	TO220F	2.0
TS868C06R	SMD	60	30(Tc=119°C)	160	-40 to +150	0.74	0.20	1.25	T-pack(S)	1.6
YA862C10R		100	10(Tc=132°C)	125	-40 to +150	0.86	0.15	2.0	TO220AB	2.0
YG862C10R		100	10(Tc=118°C)	125	-40 to +150	0.86	0.15	3.5	TO220F	2.0
TS862C10R	SMD	100	10(Tc=132°C)	125	-40 to +150	0.86	0.15	2.0	T-pack(S)	1.6
YA865C10R		100	20(Tc=117°C)	145	-40 to +150	0.86	0.175	1.75	TO220AB	2.0
YG865C10R		100	20(Tc=103°C)	145	-40 to +150	0.86	0.175	2.5	TO220F	2.0
TS865C10R	SMD	100	20(Tc=117°C)	145	-40 to +150	0.86	0.18	1.75	T-pack(S)	1.6
YA868C10R		100	30(Tc=113°C)	160	-40 to +150	0.86	0.20	1.25	TO220AB	2.0
YG868C10R		100	30(Tc=91°C)	160	-40 to +150	0.86	0.20	2.0	TO220F	2.0
TS868C10R	SMD	100	30(Tc=113°C)	160	-40 to +150	0.86	0.20	1.25	T-pack(S)	1.6

( ) 条件

\*1 50Hz方形波 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms. \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2 (Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

■ スーパー-LLD I (PFC回路用) Super LLD I (Continuous mode PFC)

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics				パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>p</sub> (Max) <sup>*1</sup> Amps.	I <sub>FSM</sub> <sup>*2</sup> Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> <sup>*3</sup> Max. μA	trr <sup>*4</sup> μ sec.	R <sub>th</sub> (j-c) °C/W		
YA961S6R		600	8	15	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =8A)	50	0.023	6.0	TO-220AB	2.0
YG961S6R		600	8	15	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =8A)	50	0.023	10.0	TO-220F	2.0
YA962S6R		600	10	25	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =10A)	50	0.025	5.0	TO-220AB	2.0
YG962S6R		600	10	25	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =10A)	50	0.025	5.0	TO-220F	2.0
YA963S6R		600	15	40	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =15A)	50	0.03	2.0	TO-220AB	2.0
YG963S6R		600	15	40	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =15A)	50	0.03	3.5	TO-220F	2.0
YG965C6R		600	20	25	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =10A)	50	0.025	3.5	TO-220F	2.0
TS965C6R	SMD	600	20	25	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =10A)	50	0.025	2.5	T-pack(S)	1.6
PH965C6		600	20	25	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =10A)	50	0.025	2.2	TO-247	4.9
YG967C6R		600	30	40	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =15A)	50	0.03	2.5	TO-220F	2.0
TS967C6R	SMD	600	30	40	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =15A)	50	0.03	2.0	T-pack(S)	1.6
PH967C6		600	30	40	-40 to +150	5.0(I <sub>F</sub> =15A)	50	0.03	1.5	TO-247	4.9

■ スーパー-LLD II (PFC回路用) Super LLD II (Discontinuous mode PFC)

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics				パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> (Max) Amps.	I <sub>FSM</sub> <sup>*2</sup> Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> <sup>*3</sup> Max. μA	trr <sup>*4</sup> μ sec.	R <sub>th</sub> (j-c) °C/W		
YA971S6R		600	8(T <sub>C</sub> =116°C)	70	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =8A)	10	0.05	2.5	TO-220AB-K1	2.0
										TO-220AB	2.0
YG971S6R		600	8(T <sub>C</sub> =89°C)	70	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =8A)	10	0.05	4.5	TO-220F	2.0
YA972S6R		600	10(T <sub>C</sub> =115°C)	100	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =10A)	10	0.05	2.0	TO-220AB-K1	2.0
										TO-220AB	2.0
YG972S6R		600	10(T <sub>C</sub> =89°C)	100	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =10A)	10	0.05	3.5	TO-220F	2.0
YA975C6R		600	20(T <sub>C</sub> =106°C)	100	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =10A)	10	0.05	1.25	TO-220AB-K1	2.0
										TO-220AB	2.0
YG975C6R		600	20(T <sub>C</sub> =89°C)	100	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =10A)	10	0.05	1.75	TO-220F	2.0
PH975C6		600	20(T <sub>C</sub> =97°C)	100	-40 to +150	1.55(I <sub>F</sub> =10A)	10	0.05	1.5	TO-247	4.9

( ) 条件

\*1 PFC回路におけるI<sub>p</sub> max値

\*2 正弦波 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub> \*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A

( ) Conditions

\*1 I<sub>p</sub> max. value at PEC circuit

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub> \*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A





# 整流ダイオード/Rectifier Diodes

## ■ 低損失超高速ダイオード Low-Loss Fast Recovery Diodes (LLD)

シングル 1 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics				パッケージ Package	質量 Net mass
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>F(AV)</sub> Amps. *1	I <sub>FSM</sub> Amps. *2	T <sub>j</sub> and T <sub>stg</sub> °C	V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> Max. μA *3	trr μ sec *4	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		Grams
ERA91-02		200	0.5 (Ta=60°C)	10	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =0.5A)	50	0.035 *4		Lead-1	0.18
ERB91-02		200	1.0 (Ta=50°C)	20	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =1.0A)	50	0.035 *4		Lead-3	0.22
ERA92-02		200	1.0 (Ta=25°C)	25	-40 to +150	1.05 (I <sub>F</sub> =1.0A)	50	0.035 *4		Lead-1	0.18
SC902-2	SMD	200	1.0 (Ta=25°C)	25	-40 to +150	1.05 (I <sub>F</sub> =1.0A)	50	0.035 *4		SC	0.06
ERB35-02		200	1.0 (Ta=25°C)	30	-40 to +150	1.1 (I <sub>F</sub> =1.0A)	10	0.1 (I <sub>F</sub> =I <sub>R</sub> =0.1A)		Lead-4	0.5
ERB93-02		200	1.5 (Ta=40°C)	25	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =1.5A)	100	0.035 *4		Lead-6	0.4
CB903-4S		400	2 (T <sub>I</sub> =97°C)	25	-40 to +150	1.5 (I <sub>F</sub> =2A)	500	0.05 *4		Lead-3	0.3
ERC35-02		200	2.5 (Ta=25°C)	50	-40 to +150	1.2 (I <sub>F</sub> =2.5A)	20	0.1 (I <sub>F</sub> =I <sub>R</sub> =0.1A)		Lead-7	1.2
ERC91-02		200	3.0 (Ta=25°C)	50	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =3.0A)	100	0.035 *4		Lead-7	1.2
KS926S2	SMD	200	5 (T <sub>c</sub> =106°C)	70	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035 *4	10.0	K-pack(S)	0.6
KP926S2		200	5 (T <sub>c</sub> =106°C)	70	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035 *4	10.0	K-pack(P)	0.6
YG911S2R		200	5 (T <sub>c</sub> =134°C)	50	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035 *4	3.5	TO-220F-K1	2.0
										TO-220F	2.0
YG911S3R		300	5 (T <sub>c</sub> =128°C)	40	-40 to +150	1.2 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035 *4	3.5	TO-220F-K1	2.0
										TO-220F	2.0
YG912S2R		200	10 (T <sub>c</sub> =116°C)	80	-40 to +150	0.98 (I <sub>F</sub> =10A)	200	0.035 *4	3.5	TO-220F	2.0
YG912S6R		600	10 (T <sub>c</sub> =93°C)	120	-40 to +150	1.7 (I <sub>F</sub> =10A)	100	0.05 *4	3.5	TO-220F	2.0

デュアル 2 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics(Ta=25°C)				パッケージ Package	質量 Net mass
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>o</sub> Amps. *1	I <sub>FSM</sub> Amps. *2	T <sub>j</sub> and T <sub>stg</sub> °C	V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> Max. μA *3	trr μ sec. *4	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		Grams
KS923C2	SMD	200	5 (T <sub>c</sub> =103°C)	50	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =2.5A)	100	0.035	10.0	K-pack(S)	0.6
KP923C2		200	5 (T <sub>c</sub> =103°C)	50	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =2.5A)	100	0.035	10.0	K-pack(P)	0.6
YG901C2R		200	5 (T <sub>c</sub> =120°C)	25	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =2.5A)	100	0.035	5.0	TO-220F	2.0
YG901C3R		300	5 (T <sub>c</sub> =105°C)	25	-40 to +150	1.2 (I <sub>F</sub> =2.5A)	100	0.035	5.0	TO-220F	2.0
YG902C2R		200	10 (T <sub>c</sub> =115°C)	50	-40 to +150	0.95 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035	3.5	TO-220F	2.0
YG902C3R		300	10 (T <sub>c</sub> =101°C)	40	-40 to +150	1.2 (I <sub>F</sub> =5A)	100	0.035	3.5	TO-220F	2.0
MS906C2	SMD	200	20 (T <sub>c</sub> =105°C)	80	-40 to +150	0.98 (I <sub>F</sub> =10A)	200	0.035	2.0	TFP	0.8
MS906C3	SMD	300	20 (T <sub>c</sub> =95°C)	80	-40 to +150	1.2 (I <sub>F</sub> =10A)	200	0.035	2.0	TFP	0.8
YG906C2R		200	20 (T <sub>c</sub> =102°C)	80	-40 to +150	0.98 (I <sub>F</sub> =10A)	200	0.035	2.5	TO-220F	2.0
PA905C6R		600	20 (T <sub>c</sub> =106°C)	120	-40 to +150	1.7 (I <sub>F</sub> =10A)	100	0.05	1.2	TO-3P	5.5

( ) 条件

\*1 50Hz 方形波 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub> \*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2

(Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub> \*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A

■ 低損失超高速ダイオード Low-Loss Fast Recovery Diodes (LLD)

低 IR デュアル Low-IR 2 in one-package

型式 Device type	SMD 対応品	絶対最大定格 Maximum rating			接合、保存温度 Thermal rating Tj and Tstg °C	電気的特性(Ta=25°C) Characteristics(Ta=25°C)				パッケージ Package	質量 Net mass Grams
		V <sub>RRM</sub> Volts	I <sub>O</sub> *1 Amps.	I <sub>FSM</sub> *2 Amps.		V <sub>FM</sub> Max. Volts	I <sub>RRM</sub> *3 Max. μA	trr *4 μ sec.	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W		
TS982C3R	SMD	300	10(Tc=128°C)	90	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.04	1.75	T-pack(S)	1.6
TS982C4R	SMD	400	10(Tc=125°C)	80	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.05	1.75	T-pack(S)	1.6
YA982C3R		300	10(Tc=128°C)	90	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.04	1.75	TO-220AB	2.0
YA982C4R		400	10(Tc=125°C)	80	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.05	1.75	TO-220AB	2.0
YG982C3R		300	10(Tc=112°C)	90	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.04	3	TO-220F	2.0
YG982C4R		400	10(Tc=107°C)	80	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =5A)	20	0.05	3	TO-220F	2.0
TS985C3R	SMD	300	20(Tc=118°C)	110	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.04	1.25	T-pack(S)	1.6
TS985C4R	SMD	400	20(Tc=114°C)	100	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.05	1.25	T-pack(S)	1.6
YA985C3R		300	20(Tc=118°C)	110	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.04	1.25	TO-220AB	2.0
YA985C4R		400	20(Tc=114°C)	100	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.05	1.25	TO-220AB	2.0
YG985C3R		300	20(Tc=105°C)	110	-40 to +150	1.3(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.04	1.75	TO-220F	2.0
YG985C4R		400	20(Tc=100°C)	100	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.05	1.75	TO-220F	2.0
PG985C4R		400	20(Tc=64°C)	100	-40 to +150	1.45(I <sub>F</sub> =10A)	35	0.05	3	TO-3PF	6.0

( ) 条件

\*1 50Hz方波形 duty=1/2 (センタータップ平均出力電流)

\*2 正弦波 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

\*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A

( ) Conditions

\*1 50Hz Square wave duty 1/2 (Average forward current of centertap full wave connection)

\*2 Sine wave, 10ms \*3 V<sub>R</sub>=V<sub>RRM</sub>

\*4 I<sub>F</sub>=0.1A, I<sub>R</sub>=0.2A, I<sub>rec.</sub>=0.05A